

- [1] M. Loulou, S. Ait Ali, N. Masmoudi et L. Kamoun “Conception et optimisation d’un amplificateur opérationnel rail to rail CMOS faible tension faible consommation” Lebanese Science Journal, Vol. 4, No. 1, 2003
- [2] S. Barra, Thèse Magister, université de Batna, 2008.
- [3] S. Hanfoug, Thèse Magister, université de Batna, 2008.
- [4] A. khelfa, A. Ali, ‘‘Un large bande amplificateur en mode courant réalisé à partir d’OTA et ces applications’’ mémoire d’ingéniorat, université de Biskra, 2010.
- [5] D. Modi et J. Patel, ‘‘ Design and simulation of cmos ota with 1.0 v, 55db gain & 5pf load’’, International Journal of Managing Public Sector Information and Communication Technologies, Vol. 5, No. 2, 2014.
- [6] P. Masson, “Étude par pompage de charge et par mesures de bruit basse fréquence de transistors MOS à oxynitride de grille ultra-minces”, Thèse de Doctorat, INSA Lyon, Grenoble, 1999.
- [7] Claude ORTOLLAND, “Etude des effets des contraintes mécaniques induites par les procédés de fabrication sur le comportement électrique des transistors CMOS des nœuds technologiques 65nm et en de ça”, Thèse de Doctorat, 2005 .
- [8] J. P. Colinge and F. Van De Wiele, “Physique Des Dispositifs Semi-Conducteurs”, Bruxelles, De Broeck Université, p. 388, 1996.
- [9] C. Enz, F. Krummenacher et E. A. Vittoz, “An analytical mos transistor model valid in all regions of operation and dedicated to low-voltage and low-current applications”, AnalogIntegrated Circuits And Signal Processing, vol. 8, special issue, juillet 1995.
- [10] C. Enz, F. Krummenacher et E. A. Vittoz, “An analytical mos transistor model valid in all regions of operation and dedicated to low-voltage and low-current applications”, AnalogIntegrated Circuits And Signal Processing, vol. 8, special issue, juillet 1995.
- [11] C. Enz, “Mos Transistor Model Valid in All Regions of Operation”, IEEE Transactions on MicrowaveTheory and Techniques, vol. 50, Janvier 2002.
- [12] :<http://www.polytech-lille.fr/cours-atome-circuit-integre/sc00a.htm>
- [13] S. Bernardini, “Modélisation des structures métal-oxyde-semiconducteur (MOS) : applications aux dispositifs mémoires”, Thèse de Doctorat, Université d’Aix-Marseille I, 2004
- [14] J.-P. Raskin, R. Gillon, j. chen, d. vanhoenacker-janvier, and j.-p. colinge, "accurate soi mosfet characterization at microwave frequencies for device performance optimization and analog modeling," ieee transactions on electron devices, vol. 45, pp. 1017-1025, 1998.

- [15] C. Pavageau, "Etude d'un étage de réception large bande en technologie MMIC AsGa," Rapport de stage de DEA de l'Université de Rennes I et de stage de fin d'études d'Ingénieur ESEO, Angers, au CEA, Bruyères-le-Châtel, 2002.
- [16] Jérôme Thiault, "Etude par microscopie à force atomique en trois dimensions de l'évolution de la rugosité de bord de ligne lors de la fabrication d'une grille de transistor MOS", 2006.
- [17] H. Sahraoui, B. Bouazza, K. E. Ghaffour et N. E. Chabane Sari: Modélisation des sources de bruit dans les dispositifs MOS A. Guen Bouazza, (Reçu le 03 Juin 2005, accepté le 30 Août 2005).
- [18] Walter G. Jung, Op Amp Applications, AnalogDevices, 2002, ISBN 0-916550-26-5, Alsoavailable as Op Amp Applications Handbook, Elsevier/Newnes, 2005, ISBN 0-7506-7844-5. Chapitre 1.
- [19]<http://www.electronique-mixte.fr/cours-en-electronique/electronique-analogique/amplificateur-operationnel/#symb> 17:17 28/03/16
- [20]UNIVERSITE LOUIS PASTEUR STRASBOURG (laboratoire d'électronique et de physique des systèmes instrumentaux.
- [21]Hank Zumbahlen, Basic Linear Design, AnalogDevices, 2006, ISBN: 0-915550-28-1. Alsoavailable as Linear Circuit Design Handbook, Elsevier-Newnes, 2008, ISBN-10: 0750687037, ISBN-13: 978-0750687034. Chapter 1
- [22]Walter G. Jung, Op Amp Applications, AnalogDevices, 2002, ISBN 0-916550-26-5, Alsoavailable as Op Amp Applications Handbook, Elsevier/Newnes, 2005, ISBN 0-7506-7844-5. Chapitre 1.
- [23] Paul R. Gray , Paul J. Hurst,Stephen H. Lewis, Robert G. Meyer "Analysis And Design Of AnalogIntegrated Circuits, new york John Wiley and sons, 2001, pp421-435
- [24] J.P. Martinez Brito et S. Bampi, "A DC offset and CMRR analysis in a CMOS 0.35 μ m operational transconductance amplifier using Pelgrom's area/accuracy tradeoff", Microelectronic. J (2008)
- [25] Fernando Paixão et sergio bampi "Miller ota design using a design methodology based on the gm/id and early-voltage characteristics: design considerations and experimental results"